

КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж, КТ315И, КТ315Р

Транзисторы КТ315Б кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n усилительные.

Предназначены для применения в усилителях высокой, промежуточной и низкой частоты. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами.

Тип прибора указывается в этикетке, а также на корпусе прибора в виде буквы соответствующего типоминнала.

Масса транзистора не более 0,18 г.

Тип корпуса: КТ-13.

Технические условия: ЖКЗ.365.200 ТУ.

Характеристики транзисторов КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж, КТ315И, КТ315Р:

Тип транзистора	Структура	Предельные значения параметров при $T_{п}=25^{\circ}\text{C}$						Значения параметров при $T_{п}=25^{\circ}\text{C}$						$T_{п\text{ max}}$ °C	$T_{\text{ max}}$ °C	
		$I_{к\text{ max}}$	$I_{к.и. \text{ max}}$	$U_{кэ R \text{ max}}$ ($U_{кэ0 \text{ max}}$)	$U_{кб0 \text{ max}}$	$U_{эб0 \text{ max}}$	$P_{к\text{ max}}$ ($P_{к.и. \text{ max}}$)	$h_{21э}$	$U_{кэ \text{ на с.}}$	$I_{кб0}$	$f_{гр. (f_{h21})}$	$K_{ш}$	$C_{к}$			$C_{э}$
		мА	мА	В	В	В	мВт		В	мкА	МГц	дБ	пФ			пФ
КТ315А	n-p-n	10 0	-	25	-	6	150	30...12 0	0,4	1	250	-	7	10	12 0	- 60...+1 00
КТ315Б	n-p-n	10 0	-	20	-	6	150	50...35 0	0,4	1	250	-	7	10	12 0	- 60...+1 00
КТ315В	n-p-n	10 0	-	40	-	6	150	30...12 0	0,4	1	250	-	7	10	12 0	- 60...+1 00
КТ315Г	n-p-n	10 0	-	35	-	6	150	50...35 0	0,4	1	250	-	7	10	12 0	- 60...+1 00
КТ315Д	n-p-n	10 0	-	40	-	6	150	20...90	0,6	1	250	-	7	10	12 0	- 60...+1 00
КТ315Е	n-p-n	10 0	-	35	-	6	150	50...35 0	0,6	1	250	-	7	10	12 0	- 60...+1 00

																00
КТ315Ж	n-p-n	50	-	20	-	6	100	30...25 0	0,5	1	250	-	7	10	12 0	- 60...+1 00
КТ315И	n-p-n	50	-	60	-	6	100	30	0,9	1	250	-	7	10	12 0	- 60...+1 00
КТ315Р	n-p-n	10 0	-	35	-	6	150	150...3 50	0,4	1	250	-	7	10	12 0	- 60...+1 00

Условные обозначения электрических параметров транзисторов:

- **$I_k \max$** - максимально допустимый постоянный ток коллектора транзистора.
- **$I_k \text{ и. } \max$** - максимально допустимый импульсный ток коллектора транзистора.
- **$U_{кэR} \max$** - максимальное напряжение между коллектором и эмиттером при заданном токе коллектора и сопротивлении в цепи база-эмиттер.
- **$U_{кэ0} \max$** - максимальное напряжение между коллектором и эмиттером транзистора при заданном токе коллектора и токе базы, равным нулю.
- **$U_{кб0} \max$** - максимальное напряжение коллектор-база при заданном токе коллектора и токе эмиттера, равным нулю.
- **$U_{эб0} \max$** - максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база при токе коллектора, равном нулю.
- **$P_k \max$** - максимально допустимая постоянная мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора.
- **$P_k \text{ и. } \max$** - максимально допустимая импульсная мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора.
- **$h_{21Э}$** - статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора.
- **$h_{21э}$** - коэффициент передачи тока биполярного транзистора в режиме малого сигнала в схеме с общим эмиттером.
- **$U_{кэ \text{ нас.}}$** - напряжение насыщения между коллектором и эмиттером транзистора.
- **$I_{кб0}$** - обратный ток коллектора. Ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера.
- **$f_{гр}$** - граничная частота коэффициента передачи тока.
- **$f_{h_{21}}$** - предельная частота коэффициента передачи тока биполярного транзистора.
- **$K_{ш}$** - коэффициент шума транзистора.
- **$C_{к}$** - емкость коллекторного перехода.
- **$C_{э}$** - емкость коллекторного перехода.
- **$T_p \max$** - максимально допустимая температура перехода.
- **$T \max$** - максимально допустимая температура окружающей среды.